



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100722000
2010 年 7 月 30 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA/PWR SOICパッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての一次予定の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

お客様におかれましては、本通知受領後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知後 **30 日以内**にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知の **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 **24 ヶ月**以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただきます。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan)	☐ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	HPA/PWR SOIC パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : 0.96 mils 径 Au(金)線 ボンディングワイア 変更後 : 0.96 mils 径 Cu(銅)線 ボンディングワイア			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	11 月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。尚、変更品の出荷につきましては、本通知の90日以降に予定いたしております。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)/PWR(パワーマネジメント) SOICパッケージ 一部製品について、現行 Au(金)線 ボンディングワイアを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び部材調達利便性向上の為に、これに替わり、Cu(銅)線 ボンディングワイアへ移行する予定です。現行 TI-Mexico(メキシコ)組立サイト及びボンディングワイア以外部材の変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイア	Au(金)線	Cu(銅)線
ボンディングワイア径	0.96 mils	0.96 mils

理由: 機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び部材調達利便性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
HPA00508DR	SN65HVD10QD	SN65HVD21DR	SN75HVD07DRG4	UCC25600DR
SN0801039DR	SN65HVD10QDG4	SN65HVD21DRG4	SN75HVD08D	UCC25600DRG4
SN0801039DRG4	SN65HVD10QDR	SN65HVD22D	SN75HVD08DG4	UCC28019ADR
SN0807052DR	SN65HVD10QDRG4	SN65HVD22DG4	SN75HVD08DR	UCC28019DR
SN0807052DRG4	SN65HVD1176D	SN65HVD22DR	SN75HVD08DRG4	UCC28019DRG4
SN65HVD05D	SN65HVD1176DG4	SN65HVD22DRG4	SN75HVD10D	UCC28050D
SN65HVD05DG4	SN65HVD1176DR	SN65HVD23D	SN75HVD10DG4	UCC28050DG4
SN65HVD05DR	SN65HVD1176DRG4	SN65HVD23DG4	SN75HVD10DR	UCC28050DR
SN65HVD05DRG4	SN65HVD11D	SN65HVD23DR	SN75HVD10DRG4	UCC28050DRG4
SN65HVD06D	SN65HVD11DG4	SN65HVD23DRG4	SN75HVD1176D	UCC28051DRG4
SN65HVD06DG4	SN65HVD11DR	SN65HVD24D	SN75HVD1176DG4	UCC28061DR
SN65HVD06DR	SN65HVD11DRG4	SN65HVD24DG4	SN75HVD1176DR	UCC28061DRG4
SN65HVD06DRG4	SN65HVD11QD	SN65HVD24DR	SN75HVD1176DRG4	UCC28610DR
SN65HVD07D	SN65HVD11QDG4	SN65HVD24DRG4	SN75HVD11D	UCC28810DR
SN65HVD07DG4	SN65HVD11QDR	SN65HVD251D	SN75HVD11DG4	UCC28810DRG4
SN65HVD07DR	SN65HVD12D	SN65HVD251DG4	SN75HVD11DR	UCC28811D
SN65HVD07DRG4	SN65HVD12DG4	SN65HVD251DR	SN75HVD11DRG4	UCC28811DG4
SN65HVD08D	SN65HVD12DR	SN65HVD251DRG4	SN75HVD12D	UCC38050D
SN65HVD08DG4	SN65HVD12DRG4	SN75HVD05D	SN75HVD12DG4	UCC38050DG4
SN65HVD08DR	SN65HVD20D	SN75HVD05DG4	SN75HVD12DR	UCC38051D
SN65HVD08DRG4	SN65HVD20DG4	SN75HVD06D	SN75HVD12DRG4	UCC38051DG4
SN65HVD10D	SN65HVD20DR	SN75HVD06DG4	TPS2370DR	
SN65HVD10DG4	SN65HVD20DRG4	SN75HVD06DR	TPS2370DRG4	
SN65HVD10DR	SN65HVD21D	SN75HVD06DRG4	TPS2371D	
SN65HVD10DRG4	SN65HVD21DG4	SN75HVD07DR	TPS2371DG4	

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010 年 7 月	終了	2010 年 9 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device1	Device2	Device3	
Qual Device:	SN65HVD11D	SN65HVD251D	UCC28051D	
Die Sizes (mm):	1.98 X 3.05	2.95 X 1.58	1.47 X 1.58	
Assembly Site:	FMX	FMX	FMX	
Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	SOIC/D/8	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4147858	4147858	4147858	
Mold Compound:	4205694	4205694	4205694	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia. Cu	0.96 Mil Dia. Cu	0.96 Mil Dia. Cu	
Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	JEDEC L-1/260C	JEDEC L-1/260C	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Device1	Device2	Device3
Electrical Characterization	-	30	30	30
**High Temp Storage Bake	170C, 420 Hrs.	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs.	77	77	77
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles	77	77	77
**Temp Cycle	-55C/125C, 1000 cycles	77	77	77
Destructive Physical Analysis	Post Temp Cycle	per spec	per spec	per spec
Manufacturability (Assembly)	per assembly site spec	per spec	per spec	per spec
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-1/260C				